
	<h2>SI7868ADP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7868ADP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 40A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7868ADP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 22373 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7868ADP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 40A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	22373 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 40A (Tc) 5.4W (Ta), 83W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5.4W (Ta), 83W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.25 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.6V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	150nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6110pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI7868ADP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7868ADP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7868ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7868ADP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI786LG SIX SI786LG SIX	 SI7868ADP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 40A PPAK SO-8	 SI7868DP-T1 VISHAY SI7868DP-T1 VISHAY	 SI7866DP-T1-GE3 V SI7866DP-T1-GE3 V
 SI7868ADP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 40A PPAK SO-8	 SI7868DP-T1-GE3 VB SI7868DP-T1-GE3 VB	 SI7866DP-T1-E3 VISHAY VISHAY QFN	 SI7868ADP SI SI7868ADP SI

heiße Teile

Mehr

SI7860DP-T1-E3	SI7860DP-T1-GE3	SI7860DP-T1-GE3	SI7860DP-T1-E3	SI7862ADP
SI7862ADP-T1-E3	SI7862ADP-T1-E3	SI7862ADP-T1-GE3	SI7862ADP-T1-GE3	SI7862DP
SI7862DP-T1	SI7864ADP	SI7864ADP-T1-GE3	SI7864DP-T1-GE3	SI7866ADP
SI7866ADP-T1-E3	SI7866ADP-T1-E3	SI7866ADP-T1-GE3	SI7866ADP-T1-GE3	SI7866DP-T1
SI7866DP-T1-E3	SI7866DP-T1-GE3	SI7868ADP	SI7868ADP-T1-E3	SI7868ADP-T1-E3
SI7868ADP-T1-GE3	SI7868DP-T1	SI7868DP-T1-E3	SI7868DP-T1-GE3	SI7868LG-T1
SI786LG-T1-E3	SI7872DP	SI7872DP-T1-E3	SI7872DP-T1-E3	SI7872DP-T1-GE3
SI7872DP-T1-GE3	SI7880ADP-T1-E3	SI7880ADP-T1-E3	SI7880ADP-T1-GE3	SI7880ADP-T1-GE3
SI7880DP-T1-GE3	SI7882DP-T1-E3	SI7882DP-T1-E3	SI7882DP-T1-GE3	SI7882DP-T1-GE3
SI7884BDP	SI7884BDP-T1-E3	SI7884BDP-T1-E3	SI7884BDP-T1-GE3	SI7884BDP-T1-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited